

投稿须知

《半导体学报》是中国电子学会和中国科学院半导体研究所共同主办的国家一级刊物（月刊，国内外公开发行），被EI、CA、SA、AJ等收录，主要报道半导体物理、材料、器件、集成电路、工艺等领域的最新科研成果。

1 总则

请遵守学术规范和准则，勿一稿多投，在稿件中勿出现抄袭、剽窃他人成果的内容。作者向《半导体学报》投稿，意味着在稿件被录用后作者同意把该文的版权（含光盘、网络等各种介质）转让给《半导体学报》编辑部。稿件必须用英文撰写，用A4纸单栏、隔行排版，字号不小于五号字。如果文章需要快速发表，需和编辑部联系并说明理由。

2 来稿要求

稿件应观点明确，数据可靠，言简意赅，重点突出。与本文内容类似或密切相关的已发表论文，应列入参考文献，以示尊重。

2.1 题目、作者、单位和摘要

题目应简洁、准确，不宜太长，题目不宜超过10个实词。文章的作者署名在投稿时应明确，以后不宜更改。作者单位需写出全称、所在城市和邮政编码。摘要应语义确切，表述简明，宜用第三人称写明论文的目的、方法、结果和结论。文后需附中文题目、作者、单位、摘要和关键词。

2.2 关键词、PACC 或 EEACC

应给出反映文章特征内容，通用性比较强的关键词 3~6 个；PACC 或 EEACC 专业代码 1~3 个。

2.3 基金及其批准号

若文章得到省、部级以上基金资助，应给出基金的全称及其批准号。

2.4 缩略词、符号及计量单位

摘要和正文中的缩略词在第一次出现时都必须写出全称。外文字母、符号必须分清大小写，正、斜体，上、下角。计量单位请用国家法定计量单位，全文文种要始终一致。

2.5 图、照片、表

图和照片按出现先后顺序编号，图的宽度一般不超过 8cm，图框宜细，刻度向里，曲线略粗，墨色要黑，线条要匀，图中文字应与正文一致。照片要求黑白反差大，层次清晰。表格应简洁、明确，宜用三线表。

正式排版时将直接采用作者提供的图，因此需要作者提供高质量的图。在图被缩小至半栏或通栏尺寸时，图中的文字和线条必须保持清晰，文字大小合适（6 号字），坐标刻度疏密适中。

在电子版中可免费使用彩色图或照片，如果在印刷版中使用彩色图或照片，每页需附 1200 元费用。

2.6 参考文献

参考文献按在正文中出现的顺序编号，用方括号括住置引文处右上角，并与文末参考文献序码对应一致。请勿引用尚未公开发表的资料，中文参考文献需翻译成相应的英译。参考文献著录项目应齐全。

期刊的格式为：作者（列前三名）. 题目. 刊名, 年份, 卷（期）：页码

例：Zhang Heqiu, Mao Lingfeng, Xu Mingzhen, et al. Effect of neutral traps on tunneling current and SILC in ultrathin oxide layer. Chinese Journal of Semiconductors, 2002, 23(4):367

书籍的格式为：作者（列前三名）. 书名. 出版地：出版社, 年份

例：Schroder D K. Semiconductor material and device characterization. New York: John Wiley & Sons, 1990

3 评审

来稿将送有关专家审阅。审稿周期大约为 45 天。作者在收到修改意见后，须在 3 周内修改完成。刊登与否由编委最后审定。不拟刊登之稿，会尽快函告作者。

4 投稿

请登录《半导体学报》网站投稿，不接收 Email 或邮寄投稿。有关稿件状况可在网上查询。接收 LaTeX 文件，在稿件被录用后如果能提供 LaTeX 源文件将有助于文章的快速发表。

通信地址: 北京 912 信箱《半导体学报》编辑部

邮政编码: 100083

电话: (010) 82304277 传真: (010) 82305052

Email: jos@semi.ac.cn

<http://www.jos.ac.cn>